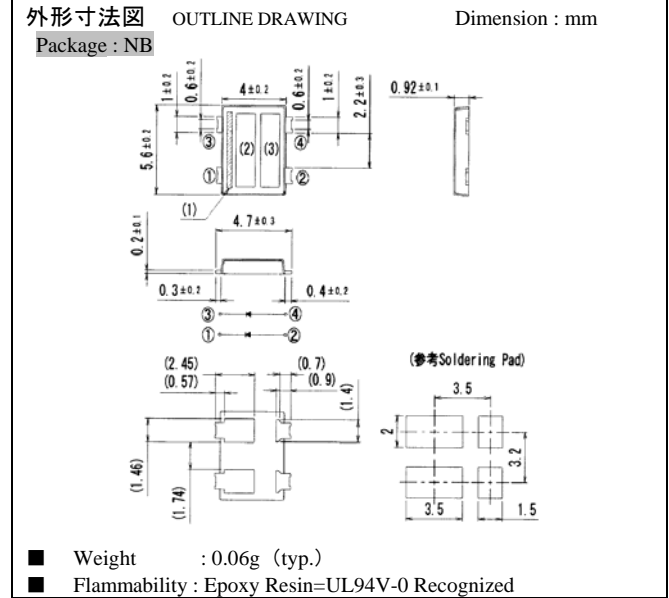


**NB10HSA08**

構造：ショットキーバリアダイオード (SBD)  
 Construction : Schottky Barrier Diode  
 用途：高周波整流用  
 Application : High-Frequency Rectification

**特長**      **Feature**  
 小型 SMD      Small SMD  
 低熱抵抗      Lower Thermal-Resistance  
 高電流      High Current Capability  
 Tj=150°C      Tj=150°C



■ 絶対最大定格 (表示無き場合 Ta=25°C) Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C unless otherwise stated)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Rating	単位 Units	
くり返しピーク逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V <sub>RRM</sub>	—	80	V	
平均整流電流 Average Rectified Output Current	I <sub>O</sub>	50Hz 正弦全波通電 抵抗負荷 *1 50H Full Sine Wave, Resistive Load	Tl=91°C, VRM=40V (Tl:Lead Temperature)	10	A
			Ta=29°C *2 VRM=40V	3.0	
実効順電流 RMS Forward Current	I <sub>F(RMS)</sub>	—	11.1	A	
サージ順電流 Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦全波 1 サイクル 非繰り返し 50Hz Full Sine Wave, 1 cycle, Non-repetitive	120	A	
動作接合温度範囲 Operation Junction Temperature Range	T <sub>jw</sub>	—	-40~+150	°C	
保存温度範囲 Storage Temperature Range	T <sub>stg</sub>	—	-40~+150	°C	

■ 電氣的・熱的特性 Electrical / Thermal Characteristics

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	最小値 min.	代表値 typ.	最大値 max.	単位 Units
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	I <sub>RM</sub>	VRM=VRRM, Tj=25°C, Per diode	—	—	100	μA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	V <sub>FM</sub>	IFM=5.0A, Tj=25°C, Per diode	—	—	0.7	V
接合容量 Junction Capacitance	C <sub>j</sub>	f=100kHz, VR=10V, Per diode	—	135	—	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	Rth(j-l)	接合部・リード間 Junction to Lead	—	—	7	°C/W
	Rth(j-a)	接合部・周囲間 Junction to Ambient	*2 (ガラスエポキシ基板実装)	—	60	°C/W

\*1 : カソード共通動作による / Common Cathode Operation

\*2 : プリント基板実装 / Glass-Epoxy Substrate Mounted (Soldering Land=2.0\*1.5mm,2.0\*3.5mm,Both Sides)

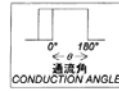
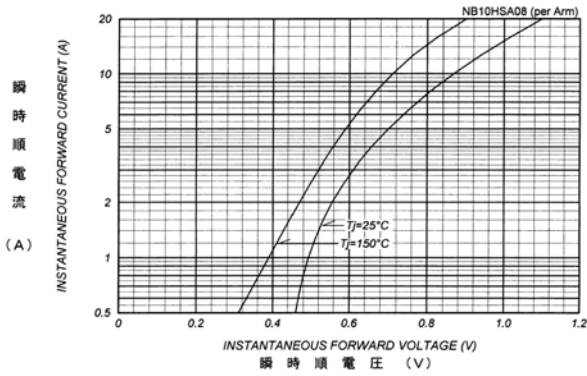
- 本資料の記載内容は製品改良などのため予告なく変更することがあります。
- The content specified herein is subject to change without notice.

NB10HSA08

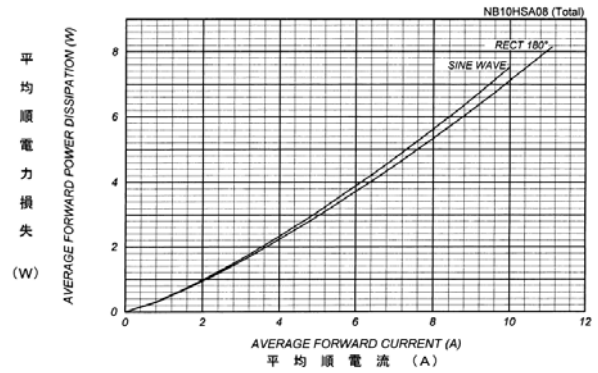
DSE-13051 (2/2)

■ 特性図 Characteristics Diagrams

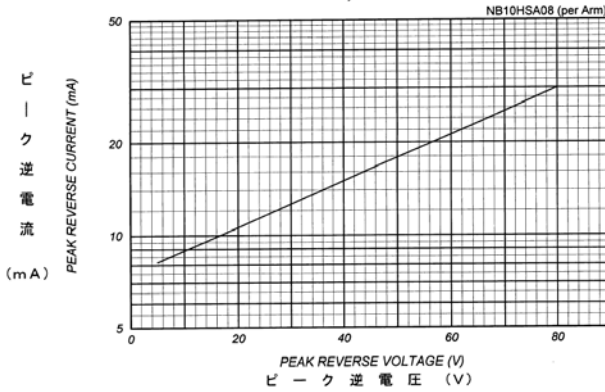
順電圧特性  
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE



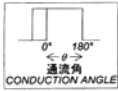
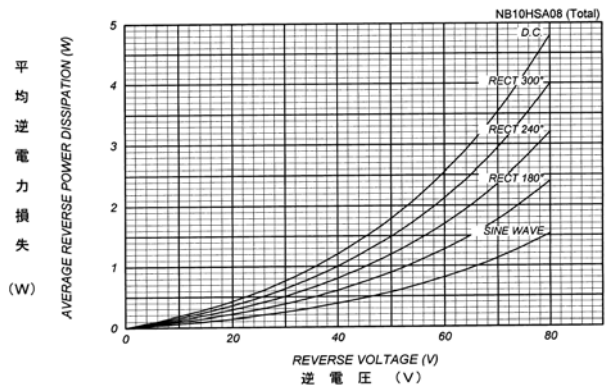
平均順電力損失特性  
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION



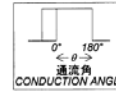
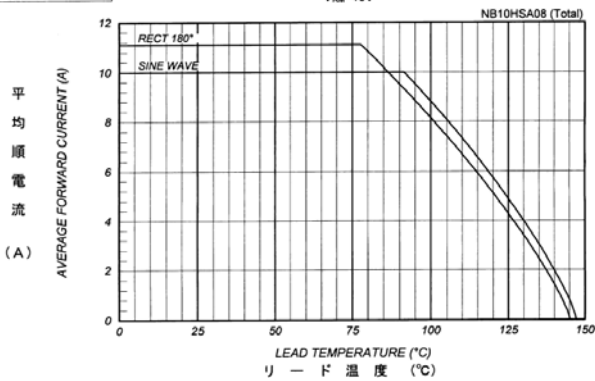
ピーク逆電流 - ピーク逆電圧特性  
PEAK REVERSE CURRENT VS. PEAK REVERSE VOLTAGE  
Tj = 150 °C



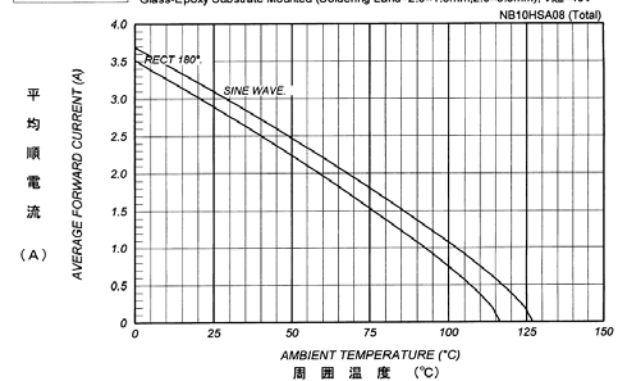
平均逆電力損失  
AVERAGE REVERSE POWER DISSIPATION



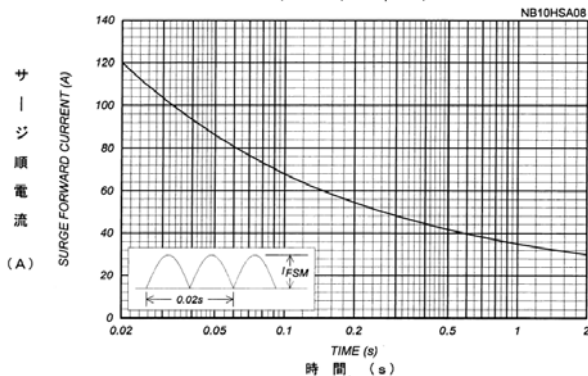
平均順電流 - リード温度定格  
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. LEAD TEMPERATURE  
V<sub>RM</sub> = 40V



平均順電流 - 周囲温度定格  
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE  
Glass-Epoxy Substrate Mounted (Soldering Land=2.0x1.5mm, 2.0x3.5mm), V<sub>RM</sub> = 40V



サージ順電流定格  
SURGE CURRENT RATINGS  
f = 50Hz, Sine Wave, Non-Repetitive, No Load



接合容量特性  
JUNCTION CAPACITANCE VS. REVERSE VOLTAGE

